


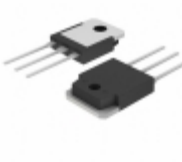






	<h2 style="color: #C00000;">GP1M009A090N</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	GP1M009A090N
	Hersteller / Marke:	Global Power Technologies Group
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 900V 9.5A TO3PN
Datenblätter:	 GP1M009A090N.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 1315 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	GP1M009A090N
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 9.5A TO3PN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1315 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Verlustleistung (max)	312W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 4.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	65nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2324pF @ 25V
Verpackung	Tube

GP1M009A090N ist neu im Original, Suche GP1M009A090N Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie GP1M009A090N Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen. Anfrage GP1M009A090N: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>GP1M010A080FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 9.5A TO220F</p>	 <p>GP1M010A080N Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 10A TO3PN</p>	 <p>GP1M010A080H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 9.5A TO220</p>	 <p>GP1M009A070F Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 700V 9A TO220F</p>
 <p>GP1M009A090H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 9A TO220</p>	 <p>GP1M010A060H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 10A TO220</p>	 <p>GP1M009A060H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 9A TO220</p>	 <p>GP1M010A060FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 10A TO220F</p>

heiße Teile

Mehr

 GP1FA51TKOF	 GP1FA550RZ	 GP1FA550TZ	 GP1FA551	 GP1FA551TZ
 GP1FA553RZ0F	 GP1FA553RZ0F	 GP1FA553TZ0F	 GP1FAV31TK0F	 GP1FAV50RK0F
 GP1FAV50TK0F	 GP1FAV51TK0F	 GP1FD320TP0F	 GP1FM313TMF5	 GP1FM313TZMF
 GP1FSV51TK0F	 GP1L53VJ000F	 GP1L57J0000F	 GP1M003A050FG	 GP1M003A080CH
 GP1M003A090C	 GP1M006A070FH	 GP1M007A090H	 GP1M008A025PG	 GP1M009A020FG
 GP1M010A060H	 GP1M010A080FH	 GP1M011A050FH	 GP1M013A050H	 GP1M016A025CG
 GP1M016A060F	 GP1M016A060H	 GP1S092HCPI	 GP1S092HCPIF	 GP1S092HCPIF
 GP1S092HCPKF	 GP1S093HCZ	 GP1S093HCZ0F	 GP1S093HCZ0F	 GP1S093HCZ0F
 GP1S094HCZ0F	 GP1S094HCZ0F	 GP1S094HCZOF	 GP1S096HCZ	 GP1S096HCZ0F
 GP1S096HCZOF	 GP1S097HCZ0F	 GP1S194HCZ0F	 GP1S194HCZ0F	 GP1S195HCPS4

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited